Министерство науки и высшего образования Российской Федерации МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Определение добротности колебательного контура

Руководитель,	
ассистент, кандидат физмат. наук	Амброзевич С.А

Реферат

В работе получены значения добротности параллельного контура с внешним гармоническим источником тока и заданными параметрами L, C, R — индуктивности, ёмкости и сопротивления соответственно. Для измерений использовались два подхода: измерение ширины резонансной кривой и вычисление логарифмического декремента в процессе установления и затухания колебаний. Полученные значения мы сравнили с теоретическим расчётом через параметры контура и установили, что значения сходятся в рамках погрешности.

Содержание

Вв	едение		4
1	Метода	ика	5
	1.1	Исследование резонансных кривых	6
	1.2	Процессы установления и затухания	7
2	Обсуж	дение результатов	S
Заг	ключен	ие	11
Сп	исок и	спользованных источников	19

Введение

Добротностью колебательной системы Q в широком смыслы называют отношение запасённой в системе энергии к потере этой энергии за время изменения фазы колебания на 1 радиан. Перед нами стоит проблема измерения этой важнейшей характеристики, так как именно системы с $Q\gg 1$ представляют большой практический интерес (системы со слабым затуханием). Применение таких систем обуславливается их стабильностью во времени, так как потери энергии относительно малы.

В нашем случае в роли такой системы будет выступать колебательный контур, добротность которого была измерена с помощью несколькими способами с помощью современного оборудования.

1 Методика

Для измерения добротности колебательного контура, мы использовали генератор сигналов, подключенный параллельно контуру и меняющийся по гармоническому закону и цифровой осциллограф, который был подключен параллельно ёмкости контура.

Полная схема экспериментальной установки, использованной в работе, изображена на рис. 1.1.

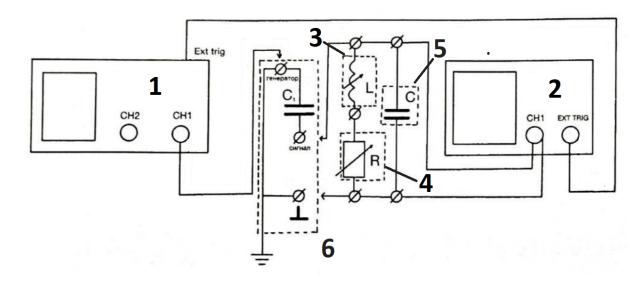


Рисунок 1.1 — Экспериментальная установка: 1) Генератор сигналов АКИП-3409/4; 2) Цифровой осциллограф ADS-2121MV; 3) Магазин индуктивностей P567 с индуктивностью L и сопротивлением R_L ; 4) Магазин сопротивлений МСР-60 сопротивления R; 5) Конденсатор ёмкости C; 6) Конденсатор ёмкости C_1 .

Ёмкость C_1 необходима для того, чтобы выходной импенданс генератора был много меньше импенданса контура и не влиял на процессы, происходящие в контуре.

Параметры установки:

$$C = 100.0 \pm 0.3 \; \text{п}\Phi$$
 $L = 100.0 \pm 0.2 \; \text{м}\Gamma\text{H}$ $R_L = 30.4 \pm 0.1 \; \text{Ом}$

Были проведены две серии измерений каждого из подходов, по одной на каждое из двух значений дополительного сопротивления в контуре:

$$R_1 = 30.0 \pm 0.1 \; \mathrm{MOM}$$
 $R_2 = 100.02 \pm 0.3 \; \mathrm{OM}$

При заведомо большой добротности можно воспользоваться формулой 1.1.

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \tag{1.1}$$

1.1 Исследование резонансных кривых

При подключении к контуру внешнего синусоидального источник в нём возникают колебания, которые можно представить как суперпозицию двух синусоид (1.2 [1, раздел II]): первая – с частотой собственных колебаний контура и амплитудой, экспоненциально убывающей со временем; вторая – с частотой внешнего истоничка и постоянной амплитудой:

$$U_c(t) = \frac{Q\mathcal{E}_0\omega_0/\omega}{\sqrt{1 + (\tau\Delta\omega)^2}} \left[\sin(\omega t - \psi_I) - e^{-\gamma t}\sin(\omega_0 t - \psi_I)\right]$$
(1.2)

Со временем собственные колебания затухают, и в контуре устанавливаются вынужденные колебания. Амплитуда этих колебаний максимальна при резонансе: совпадении или достаточной близости частоты внешнего сигнала и собственной частоты контура. Зависиость амплитуды установившихся колебаний от частоты внешнего сигнала называется резонансной кривой.

В экспериментальном нахождении этой кривой и заключается первый подход.

Сначала по формуле 1.3 [1, раздел II] мы рассчитали резонансную частоту контура:

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi LC},\tag{1.3}$$

затем, изменяя частоту генератора вблизи резонансной частоты и наблюдая синусоиду на экране осциллографа, убедились, что амплитуда колебаний максимальна при достижении резонансной частоты.

Меняя частоту генератора в обе стороны от резонансной и снимая значения амплитуды с осциллографа, мы получили экспериментальную зависимость амплитуды напряжения на обкладках конденсатора в контуре от частоты генератора.

Таким образом, построив график в безразмерных координатах $U/U_0 = f(\nu/\nu_0)$ и измерив «ширину» кривой на уровне $\frac{1}{\sqrt{2}}$, мы можем найти значение добротности контура. Чем шире кривая, тем меньше добротность у контура.

1.2 Процессы установления и затухания

Добротность контура можно определить и другими способами, например, по скорости нарастания амплитуды вынужденных колебаний при резонансе или по скорости затухания свободных колебаний:

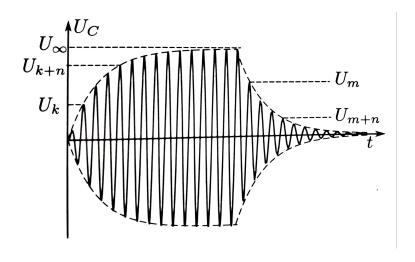


Рисунок 1.2 — Нарастание и затухание вынужденных колебаний

Нарастание и затухание колебаний (рис. 1.2) можно наблюдать на экране осциллографа, если на контур подаются цуги. Чем выше добротность, тем медленнее нарастают и медленнее убывают колебания в контуре. Получить непосредственно значение Q можно, измерив логарифмический декремент затухания по скорости нарастания или затухания

колебаний по формуле 1.4: [1, раздел II]:

$$\Theta = \frac{1}{n} \ln \frac{U_0 - U_k}{U_0 - U_{k+n}},\tag{1.4}$$

$$Q = \frac{\pi}{\Theta}.\tag{1.5}$$

2 Обсуждение результатов

При обработке полученных результатов мы получили две резонансные кривые (рис. 2.1).

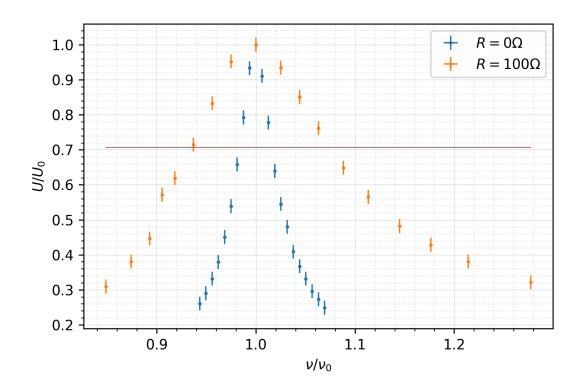


Рисунок 2.1 — Резонансные кривые в безразмерных координатах для параллельного колебательного контура, где ν_0 — резонансная частота, а U_0 — амплитуда сигнала при этой частоте

Как и ожидалось, кривая, отвечающая большему сопротивлению, шире, так как при большем сопротивлении в системе увеличиваются потери, а значит, уменьшается добротность.

Измерив ширину кривых на уровне красной линии, мы рассчитали два значения добротности контура. Далее были посчитаны значения добротности с помощью декремента затухания. Полученные результаты сведены в таблицу ??.

При вычислении добротности через функцию f(LCR), мы пользовались формулой 1.1, которая была получена для случая $Q\gg 1$. Но полученные экспериментальные значения больше 1, что говорит об уместности применения формулы.

$R ext{ Om}$	$R_{ ext{koht}}$	Рез. кривая	Возрастание	Затухание	f(LCR)
0	30.45	31.58 ± 1.32	27.54 ± 4.23	33.32 ± 5.4	32.89 ± 0.8
100	130.44	7.19 ± 0.64	7.46 ± 0.9	10.73 ± 1.2	7.67 ± 0.16

Таблица 2.1 — Результаты измерения добротности контура для двух значений $R_{\rm конт}$ тремя различными способами — по ширине резонансной кривой, по возрастанию и затуханию колебаний при подаче с внешнего генератора цугов

Заключение

Список использованных источников

1. $M.\Gamma$., Hикулин. Лабораторный практикум по общей физике: учеб. пособие. В трёх томах. Т. 2. Электричество и магнетизм / Никулин М.Г., Попов П.В., Нозик А.А. — Москва: МФТИ, 2019. — 370 с.